

а 2007 0334

Изобретение относится к области получения пленок металл оксидов, в частности  $\text{In}_2\text{O}_3$ , с большим размером атомно плоской поверхности кристаллитов.

Способ получения тонких пленок оксидных полупроводников включает осаждение пленок путем спрей пиролиза при температуре  $450 \dots 550^\circ\text{C}$  из водных растворов  $\text{InCl}_3$  с концентрацией соли металла в растворе превышающей  $0,2\text{M}$  с последующим отжигом в нейтральной или кислородсодержащей атмосфере при температуре выше  $1000^\circ\text{C}$ .

П. формулы: 2

Фиг.: 3